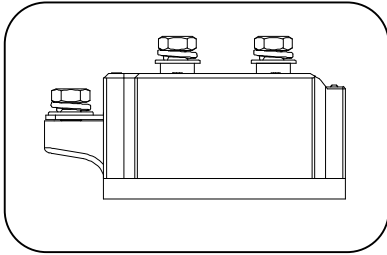


普通晶闸管模块

MTC200 MTA200 MTK200 MTX200



特点:

- n 芯片与底板电气绝缘,3600V 交流绝缘
- n 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
- n 体积小,重量轻

典型应用:

- n 交直流电机控制
- n 各种整流电源
- n 变频器

$I_{T(AV)}$	200A
V_{DRM}/V_{RRM}	600 ~ 3600V
I_{TSM}	7.2 KA
I^2t	259 $10^3 A^2S$

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $T_c=70^{\circ}C$	125			200	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			314	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125	600		3600	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	125			35	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波,	125			7.20	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6V_{RRM}$				259	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.90	V
r_T	斜率电阻					1.43	mW
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM} = 600A$	25			1.90	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM} = 67\%V_{DRM}$	125			800	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM} = 400A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM} = 1.5A$, 门极上升时间 $t_i \leq 1\mu s$	125			100	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A = 12V, I_A = 1A$	25	30		180	mA
V_{GT}	门极触发电压			1.0		3.0	V
I_H	维持电流			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM} = 67\%V_{DRM}$	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.140	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1\text{min}, I_{iso}: 1\text{mA}(\text{MAX})$		3600			V
F_m	安装扭矩(M8)				12		N·m
	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量				860		g

普通晶閘管模塊

MTC200 MTA200 MTK200 MTX200

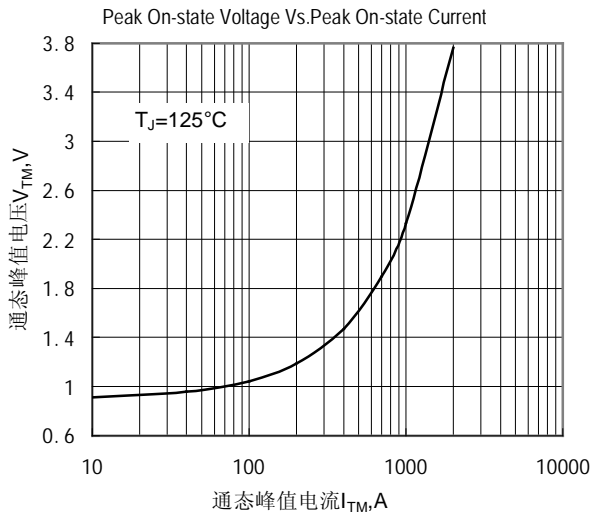


Fig.1 通態伏安特性曲線

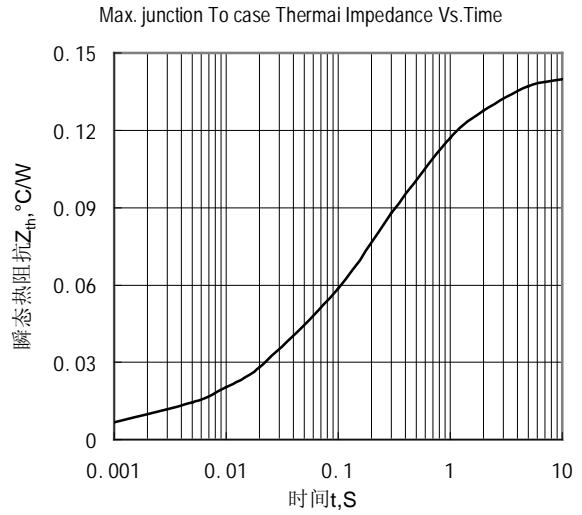


Fig.2 結至管殼瞬態熱阻抗曲線

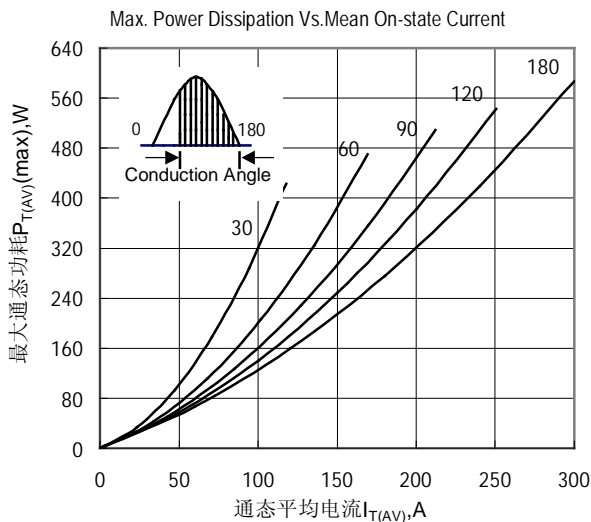


Fig.3 最大功耗與平均電流關係曲線

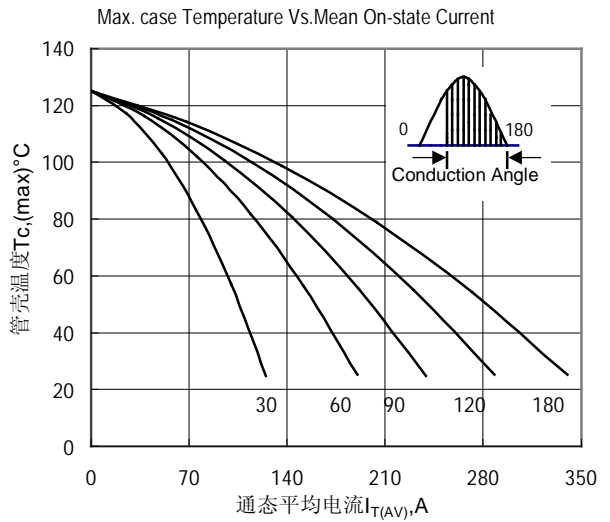


Fig.4 管殼溫度與通態平均電流關係曲線

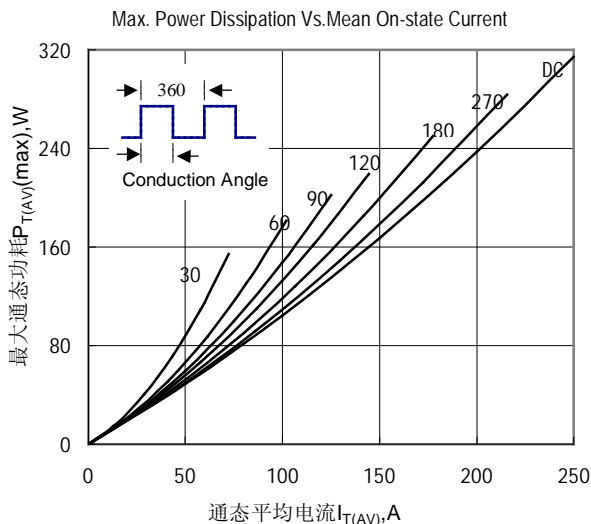


Fig.5 最大功耗與平均電流關係曲線

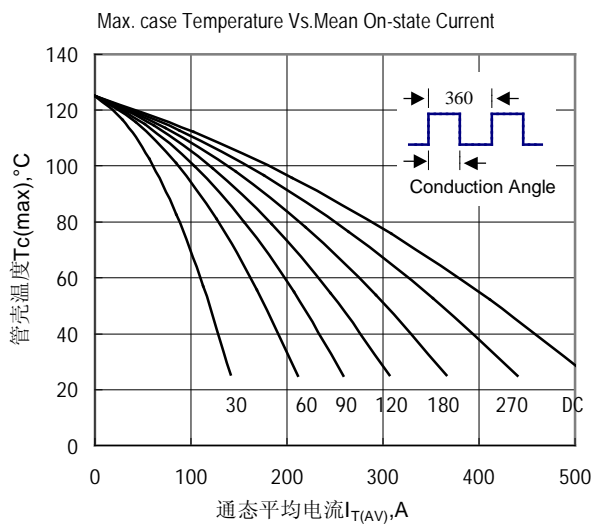


Fig.6 管殼溫度與通態平均電流關係曲線

普通晶闸管模块

MTC200 MTA200 MTK200 MTX200

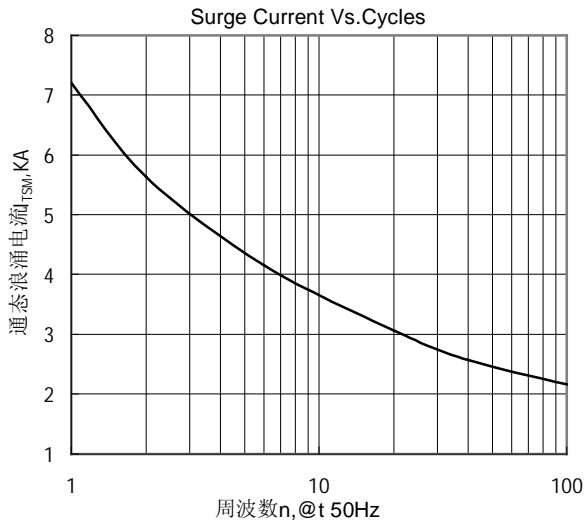


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

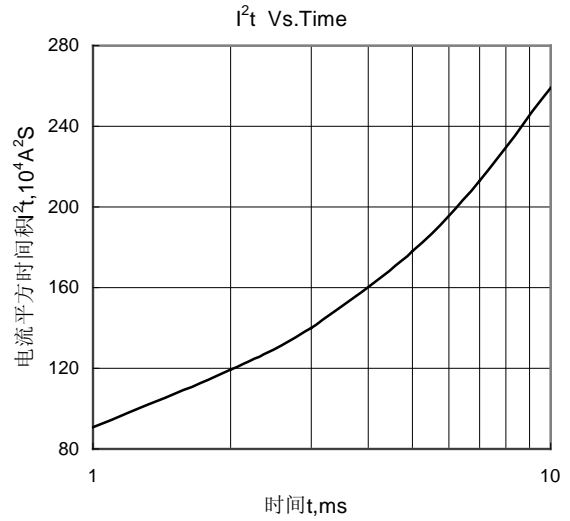


Fig.8 I²t特性曲线

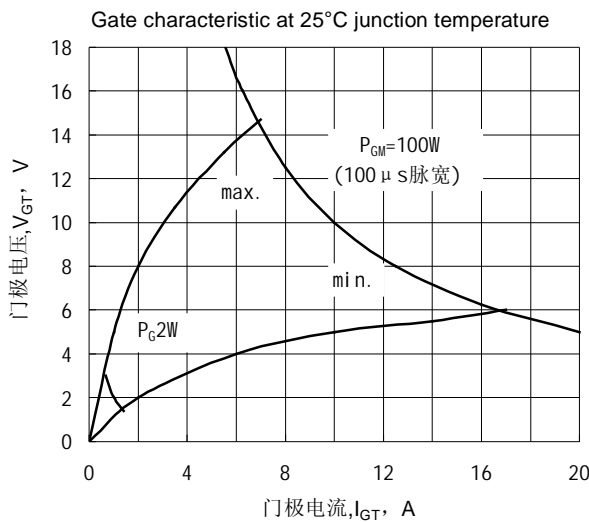


Fig.9 门极功率曲线

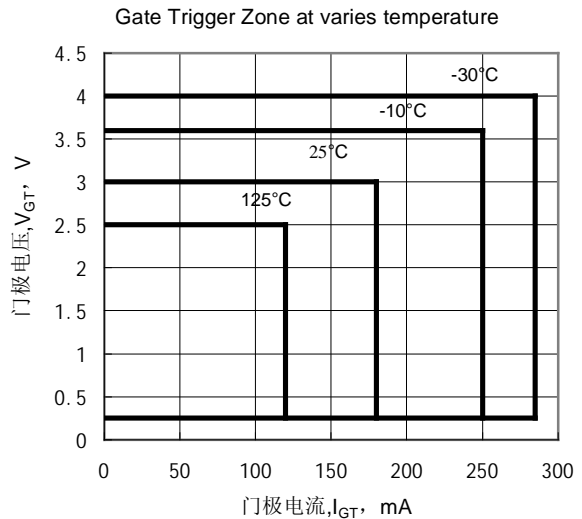


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

